



RIBER

Présentation des résultats annuels 2025

8 avril 2026

RIBER



Équipementier de référence
pour les semi-conducteurs composés

Leader mondial de la MBE

NOS RESSOURCES

Un savoir-faire industriel entièrement maîtrisé

- 100% internalisé conception, fabrication, support
- 120 collaborateurs dont 40% de cadres
- 2 filiales USA et Chine
- 12% du CA investi en R&D



NOS CONTRIBUTIONS

Un acteur structurant de la filière européenne

- 70% de fournisseurs basés en France
- Position clé dans l'écosystème des semi-conducteurs composés
- Engagement actif en matière environnementale et sociétale

NOS ATOUTS

Une technologie MBE différenciante

- Plus de 800 machines installées dans le monde
- La plus large gamme de solutions couvrant recherche et production
- 41 M€ de CA dont +90% à l'international

NOTRE AMBITION

Au cœur des enjeux technologiques stratégiques

- Répondre aux besoins en semi-conducteurs avancés
- S'intégrer dans la photonique sur Silicium
- Contribuer aux enjeux de souveraineté technologique
- Développer des collaborations structurantes : laboratoires communs, lignes pilotes, projets européens



Notre positionnement dans notre écosystème



RIBER

L'épitaxie crée l'epiwafer, cœur des puces avancées.

ex. : puce dans un transceiver

Freiburger
Compend Materials

axt

InPACT

UMS

Et plus...

IntelliEPI IQE

est

Et plus...

LUMENTUM Infinera

Et plus...

III-V lab innolume II-VI LASER ENTERPRISE Almae

Accelink TRUMPF MITSUBISHI ELECTRIC LASERTEL

Et plus...

Apple Facebook

HUAWEI Google Cloud

Et plus...

aselsan NORTHROP GRUMMAN Raytheon intel

HISILICON BAE SYSTEMS NIKO SYSTEM S.A. NOKIA

Et plus...

Chaque génération de machines RIBER a augmenté la productivité, la compatibilité matériau et l'intégration industrielle.



1978

1^{er} système
MBE industriel



1992

MBE 49
1^{er} système multi wafer
pour la production



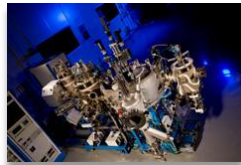
1997

MBE 6000
Passage à la
production de masse



1997

Compact 21
Design avancé pour
les systèmes
académiques



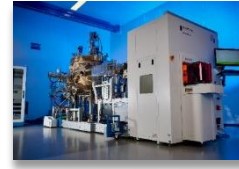
2011

Architecture cluster
pour accroître la
flexibilité des
systèmes
académiques



2024

MBE 8000
Machine la plus
productive



2025

ROSIE 1
Lancement d'un
système compatible
fab Si



2026

SUPRA
1^{er} machine dédiée
aux matériaux
supraconducteurs

2026

ROSIE 2
Production fab Si
300 mm
(cluster)

Plus de 800 systèmes opérationnels à travers le monde

DATAKOM / TÉLÉCOM



DÉFENSE ET SPATIAL



IMAGERIE MÉDICALE



AUTOMOBILE



ECRANS & DISPLAY



LED UV



PHOTONIQUE

- ▣ **Capteurs** à très haute sensibilité
- ▣ **Lasers** à grande stabilité thermique / faible consommation / longue durée de vie

▣ **μLED** avec stabilité des pixels

▣ **LED** avec la capacité de détruire l'ADN

MICRO-ÉLECTRONIQUE

- ▣ **Transistors** à très haute fréquence / faible bruit / forte vitesse

Les besoins explosent en photonique et micro-électronique avancée, entraînés par l'IA, les datacenters, la défense et le quantique.



Une offre complète et intégrée au service de la performance et de la productivité

Machines de production

MBE 49, MBE 6000

Plateformes haute productivité pour environnements industriels

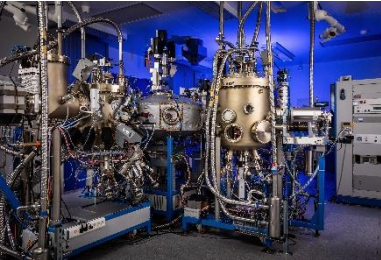


Machines de recherche

Compact 21, MBE 412,

+ SUPRA (nouveau modèle exclusif)

Flexibilité, modularité et précision pour les laboratoires avancés



Machine pour Fab Semi

ROSIE

300mm ; compatible Silicium
Nouveau marché stratégique

Services

support process et technique



Instrumentation embarquée

EZ instruments

Mesures in-situ propriétaires pour un contrôle temps réel du process



Composants

15 gammes optimisées pour la stabilité, la performance et la pureté de flux



Logiciel Crystal XE

Pilotage avancé, automatisation, analyses intégrées

RIBER

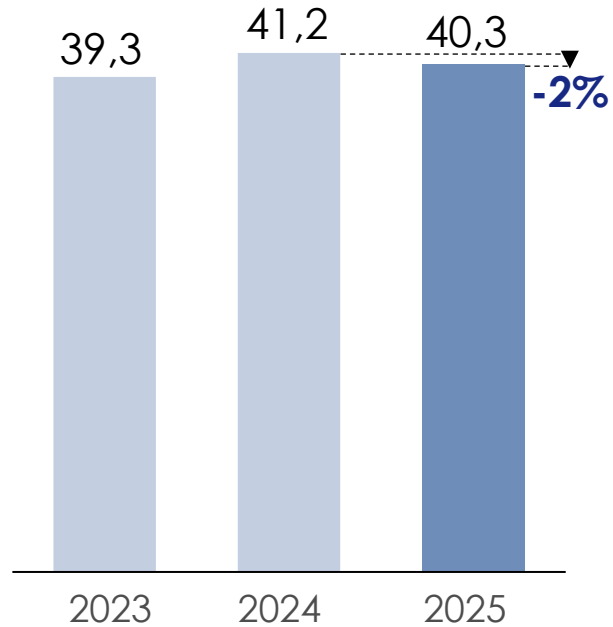


Résultats annuels 2025

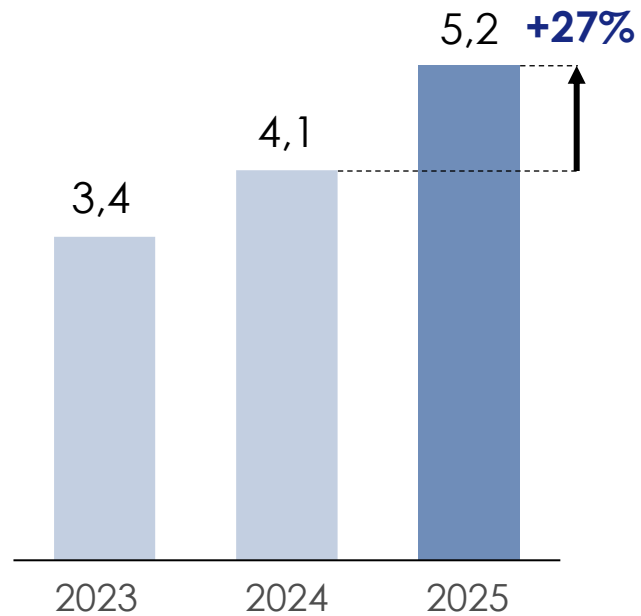
Des fondamentaux financiers renforcés

2025 : croissance conforme à l'objectif, amélioration des marges et bilan solide

Chiffre d'affaires
(en M€)

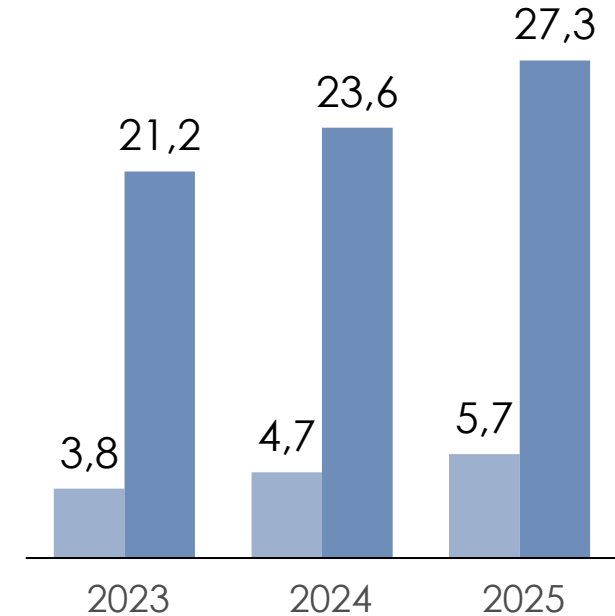


Résultat net
(en M€)



8,7%	10,0%	13,0%
(% du chiffre d'affaires)		

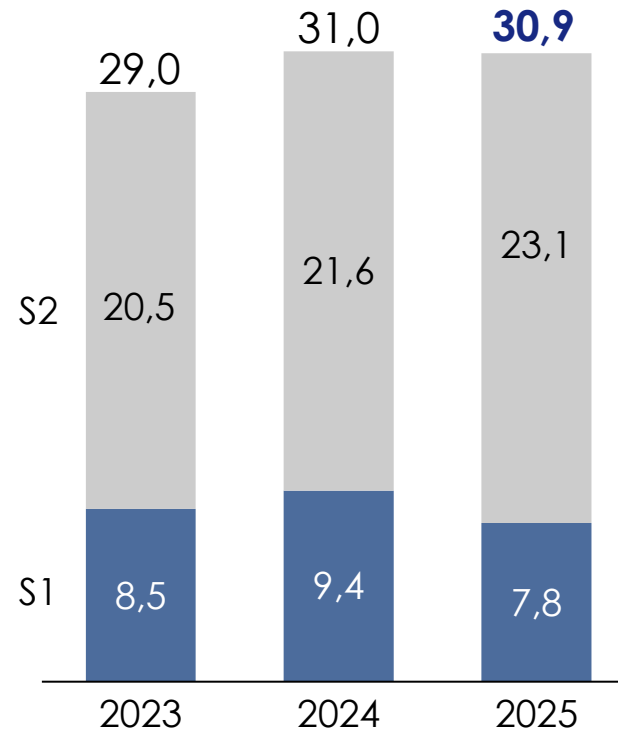
Structure financière
(en M€)



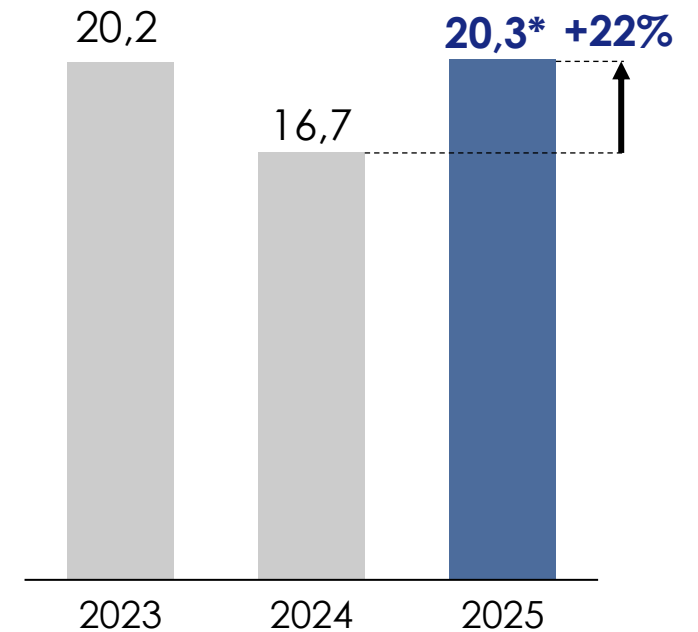
■ Trésorerie Nette
■ Capitaux propres

- 12 systèmes livrés en 2025, dont 9 machines de production
- 1^{er} exemplaire ROSIE livré au S2 2025
- Carnet à fin 2025 en hausse de +22% : 6 systèmes, dont 1 ROSIE
- 1 commande supplémentaire au Japon en janvier 2026
- Visibilité renforcée grâce à ROSIE et dynamique commerciale soutenue

Chiffre d'affaires par semestre
(en M€)



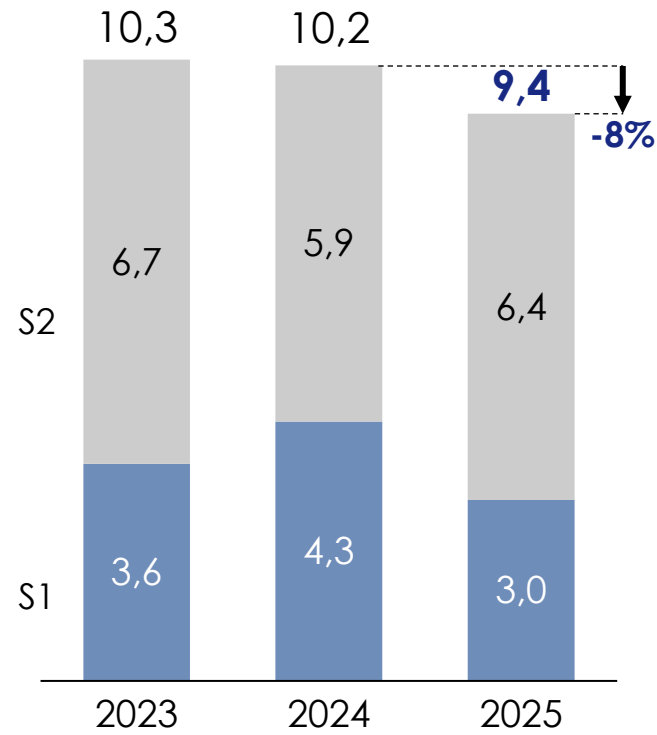
Carnet de commandes au 31 décembre
(en M€)



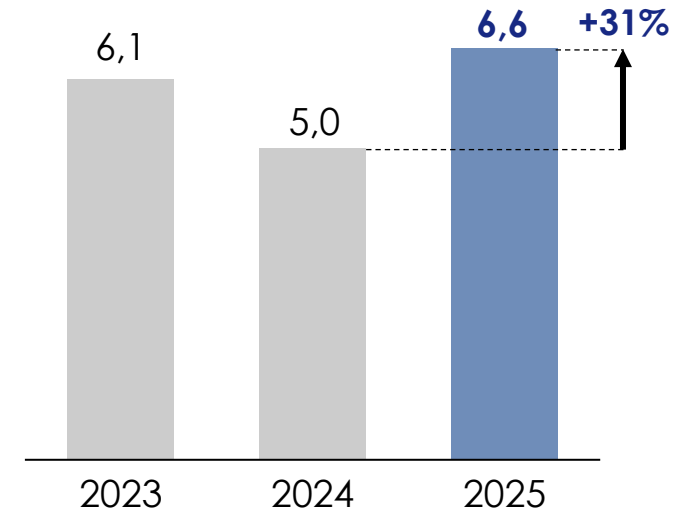
* Hors la commande de système de production annoncée en janvier 2026

- Exercice pénalisé par les restrictions budgétaires aux Etats-Unis
- Redressement au S2 : + 8,5 %
- Carnet en hausse : 6,6 M€
- Plan produits lancé pour soutenir la reprise de la croissance

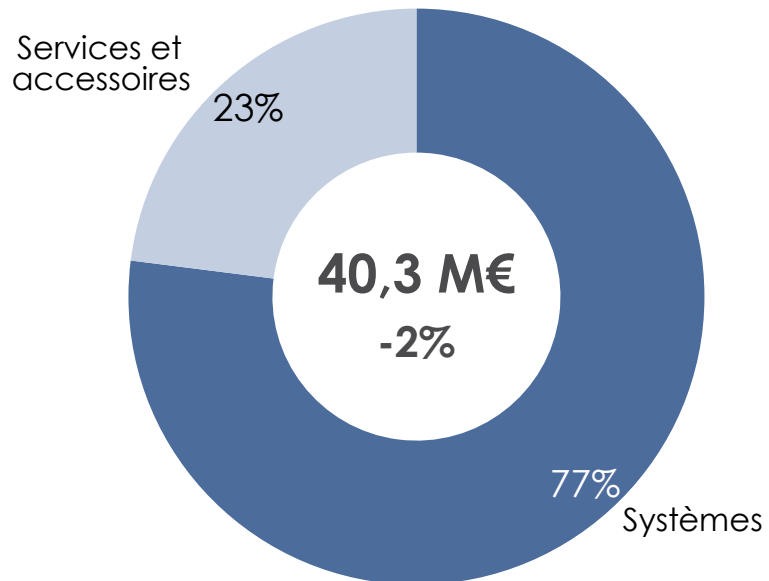
Chiffre d'affaires
par semestre
(en M€)



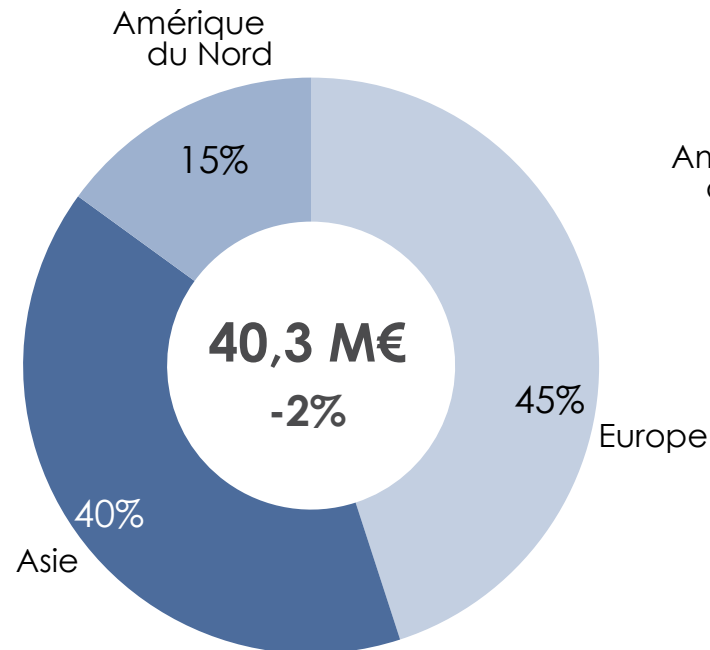
Carnet de commandes
au 31 décembre
(en M€)



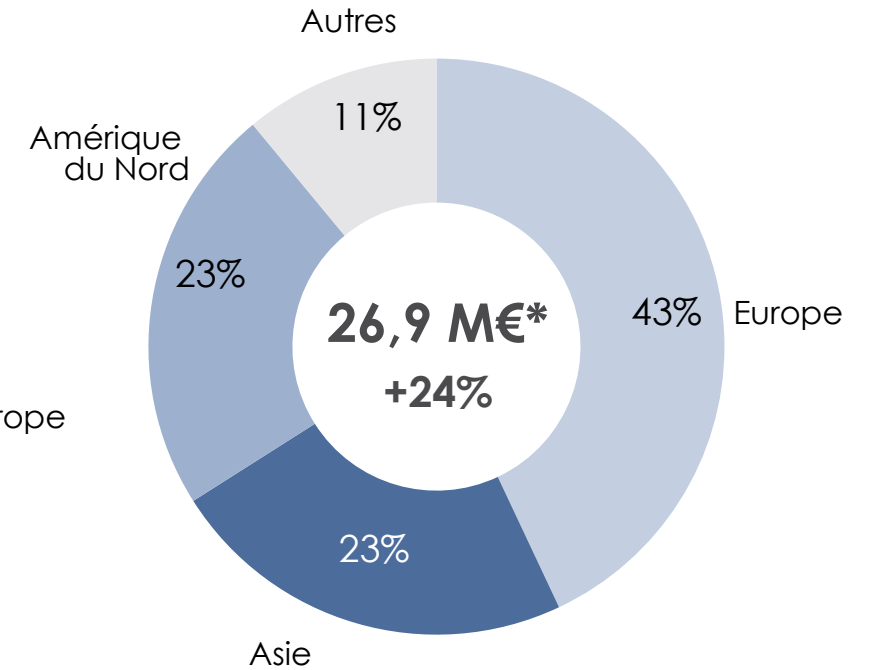
Chiffre d'affaires par activité
au 31 décembre 2025



Chiffre d'affaires par zone géographique
au 31 décembre 2025



Carnet de commandes par zone géographique
au 31 décembre 2025



* Hors la commande de système de production annoncée en janvier 2026

Compte de résultats 2025 : amélioration des marges et résultat net en forte hausse

40,3 M€

Chiffre d'affaires
(-2 %)

38,6 %

Marge brute
(+2,5 pts)

5,1 M€

Résultat opérationnel
(+17 %)

5,2 M€

Résultat net
(+27 %)

13 %

Marge nette
(+3 pts)

(en M€ - normes IFRS)	2025	2024	Δ*
Chiffre d'affaires	40,3	41,2	-2,1%
CA Systèmes	30,9	31,0	-0,3%
CA Services & accessoires	9,4	10,2	-7,8%
Marge brute	15,6	14,8	+4,7%
en % CA	38,6%	36,1%	
Commercial	-3,4	-4,2	
Recherche et développement	-3,2	-2,6	
<i>dont dépenses brutes</i>	-3,3	-3,9	
<i>dont autres éléments (CIR, activation IFRS...)</i>	0,1	1,3	
Administration	-3,9	-3,6	
Résultat opérationnel courant	5,1	4,5	+13,5%
en % CA	12,7%	10,9%	
Résultat opérationnel	5,1	4,4	+16,6%
en % CA	12,7%	10,6%	
Résultat net	5,2	4,1	+27,1%
en % CA	13,0%	10,0%	

CA en légère baisse, la **marge brute** progresse du fait de l'évolution du mix-prix-produit.

Maintient d'un effort de R&D important. (ROSIE, LAAS, CRHEA...) Activation IFRS de certaines dépenses éligibles.

Nette progression du **résultat opérationnel courant** grâce à la maîtrise des charges d'exploitation (+0,8%).

Le **résultat net** inclut une charge financière de -0,3 M€ d'effet de change Dollars, et un produit d'impôt de 0,4 M€ lié à l'activation de déficits reportables.

* évolution calculée sur une base en K€



Bilan consolidé : Renforcement des fonds propres et réduction de la dette

27,3 M€

Capitaux propres
(+3,7 M€)

1,7 M€

dette financière
(-2,2 M€)

7,5 M€

Disponibilités

13,4 M€

Avances clients
(+1,8 M€)

55,4 M€

Total bilan
(+5,5 M€)

Au 31 décembre - en M€	2025	2024	Δ
Actif immobilisé	7,2	7,9	-0,8
Impôts différés actifs	2,4	1,4	+0,9
Actifs financiers et non courant	2,2	2,5	-0,2
Stocks matières premières	8,0	8,2	-0,2
En-cours	8,9	9,7	-0,8
Créances clients	17,9	9,5	+8,4
Autres actifs courants	1,4	2,0	-0,7
Disponibilités	7,5	8,6	-1,1
ACTIF	55,4	49,9	+5,5
Capitaux propres	27,3	23,6	+3,7
Provisions	2,9	2,1	+0,8
Fournisseurs	5,3	4,3	+1,1
Avances clients	13,4	11,6	+1,8
Autres dettes d'exploitation	4,8	4,5	+0,3
Dettes financières (IFRS 16 inclus)	1,7	3,9	-2,2
PASSIF	55,4	49,9	+5,5

Tableau de flux de trésorerie consolidé

Au 31 décembre - en M€	2025	2024	Δ
Résultat net consolidé	5,2	4,1	+1,1
Effet de trésorerie d'exploitation	3,0	2,7	+0,3
Capacité d'autofinancement avant produits financiers nets et impôt société	8,2	6,8	+1,4
- Impôt société versé	(0,2)	(0,1)	-0,0
+ / - Variation du B.F.R. lié à l'activité	(3,5)	(1,7)	-1,9
Flux net généré par l'activité (a)	4,5	5,0	-0,5
Acquisitions et entrées de périmètre	0,0	0,0	-
CapEx Net	(1,7)	(2,3)	+0,6
Flux net lié aux opérations d'investissement (b)	(1,7)	(2,3)	+0,6
Distribution de sommes prélevées sur la prime d'émission	(1,7)	(1,5)	-0,2
Rachats d'actions	(0,1)	(0,1)	+0,1
Emprunts nets	(2,0)	(2,0)	+0,1
Autres	(0,2)	(0,2)	-
Flux lié aux opérations de financement (c)	(3,9)	(3,8)	-0,1
Variation de la trésorerie nette (a + b + c)	(1,0)	(1,1)	+0,1
TRÉSORERIE D'OUVERTURE	8,6	9,7	-1,1
TRÉSORERIE DE CLÔTURE	7,5	8,6	-1,1



Principaux ratios financiers 2025

Rentabilité et solidité renforcées

ROCE 17,6%

Retour sur capitaux employés

ROE 19,2%

Rentabilité des fonds propres

Gearing -21%

Dette financière nette
sur fonds propres

Autonomie financière

49,3%

fonds propres sur total de bilan

	2025	2024	Δ
ROCE (Return on Capital Employed)	17,6%	15,9%	+1,7 pts
ROE (Return on Equity)	19,2%	17,5%	+1,7 pts
Gearing	-21,0%	-20,0%	-1,0 pts
Autonomie financière	49,3%	47,3%	+2,0 pts

**STRUCTURE FINANCIÈRE TRÈS SAIN,
COMBINANT MONTÉE EN RENTABILITÉ ET ABSENCE D'ENDETTEMENT**

Distribution
(en € par action) **0,10 €**

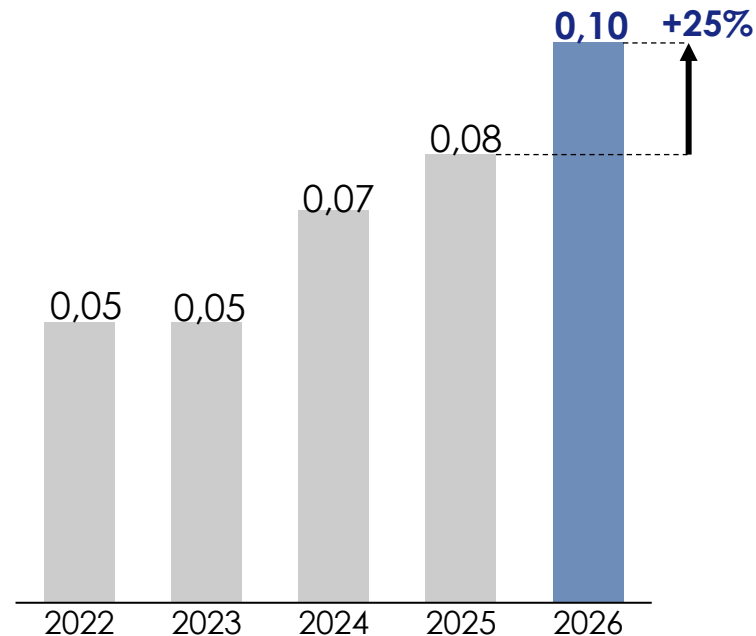
Cours au 31 décembre 2025
(en € par action) **3,50 €**

Rendement **2,9 %**

**Distribution en numéraire,
prélevée sur le compte prime d'émission**

Mise en paiement le 24 juin 2026

Évolution de la distribution
(€ / action)



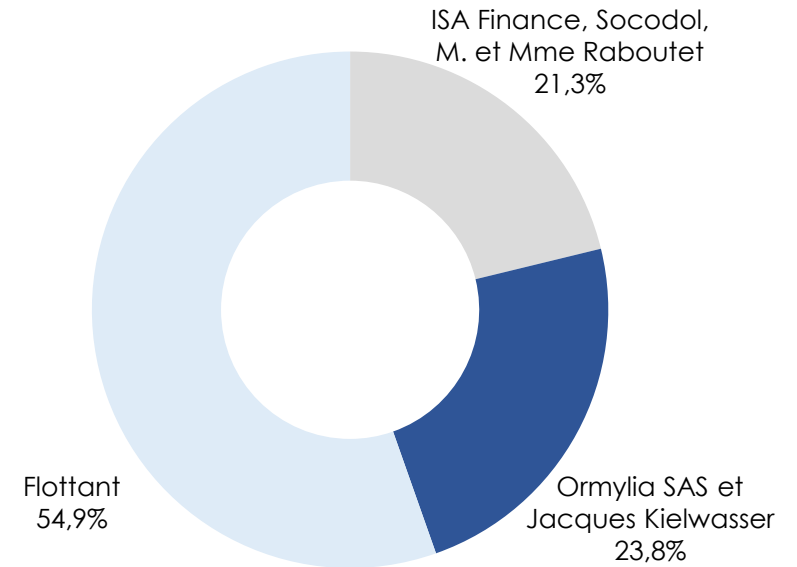
Variation du cours par rapport à l'indice CAC Mid & Small



- **Capitalisation :**
117 M€ au 01/04/2026
- **ISIN :** FR0000075954
- **Code mnémorique :** ALRIB

- **Indices**
EN GROWTH ALLSHARE,
EN TECH CROISSANCE
- **Homologation Bpifrance**

Actionnariat au 31 décembre 2025



RIBER

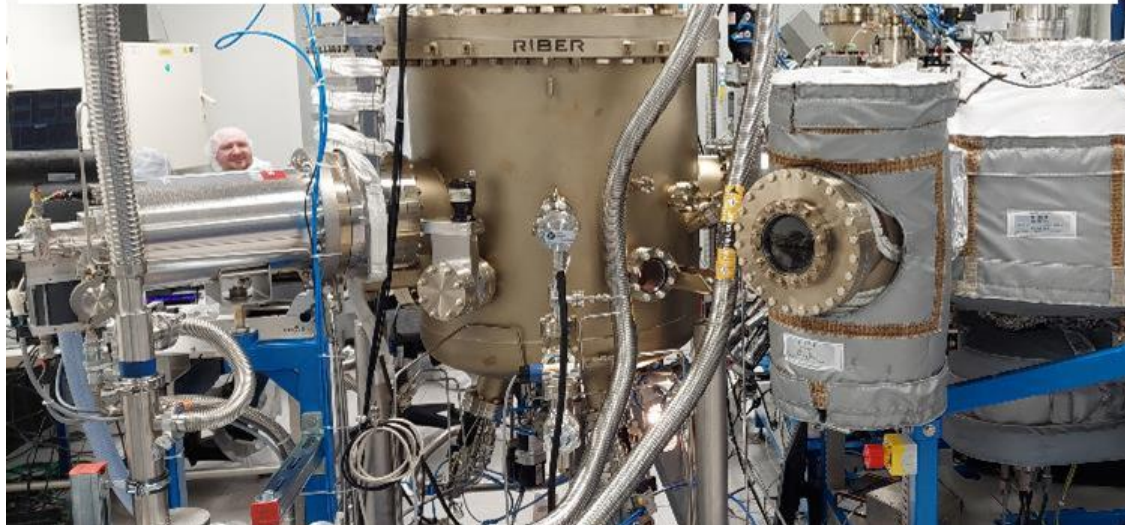


Nos perspectives de développement

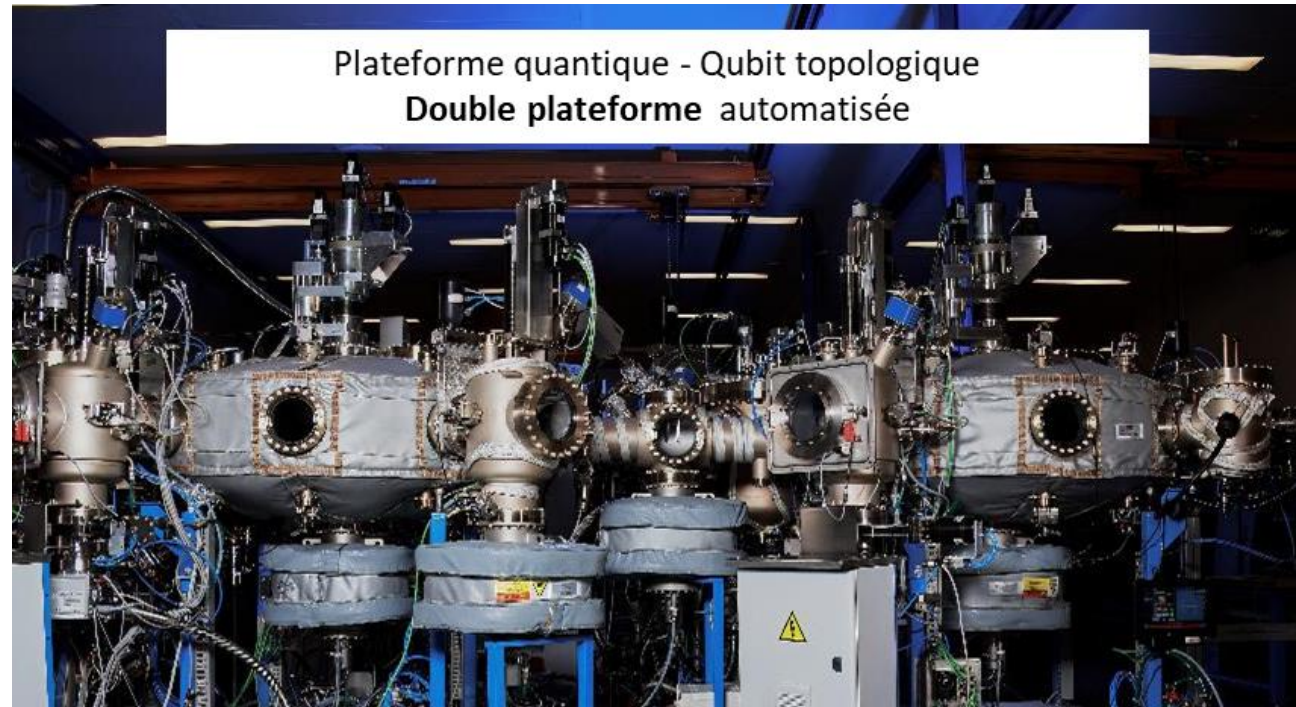
Le renforcement de la technologie MBE

Des plateformes hybrides à forte valeur ajoutée

Plateforme quantique - Qubit topologique
Chambre de depot a froid à -150°C de matériaux supraconducteur
Projet EPICENTRE - Plateforme automatisée



Plateforme quantique - Qubit topologique
Double plateforme automatisée



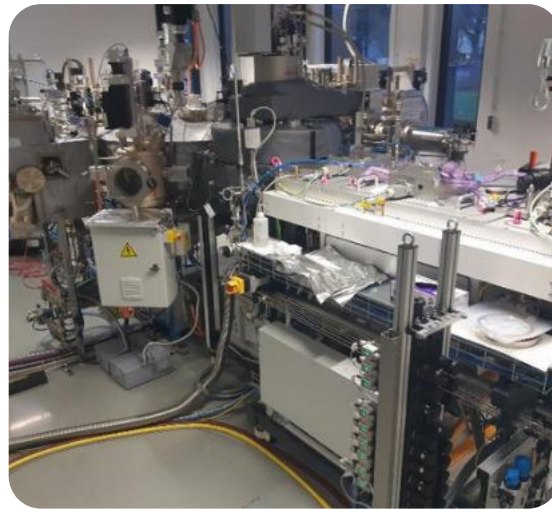
Amplifier les potentiels au moyen de l'hybridation

Modularité



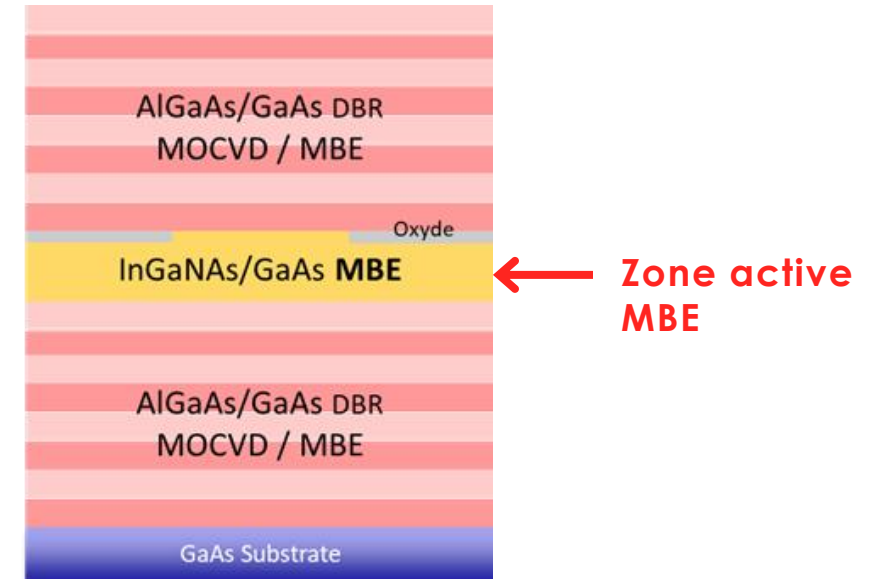
MBE + RPCVD

Flexibilité

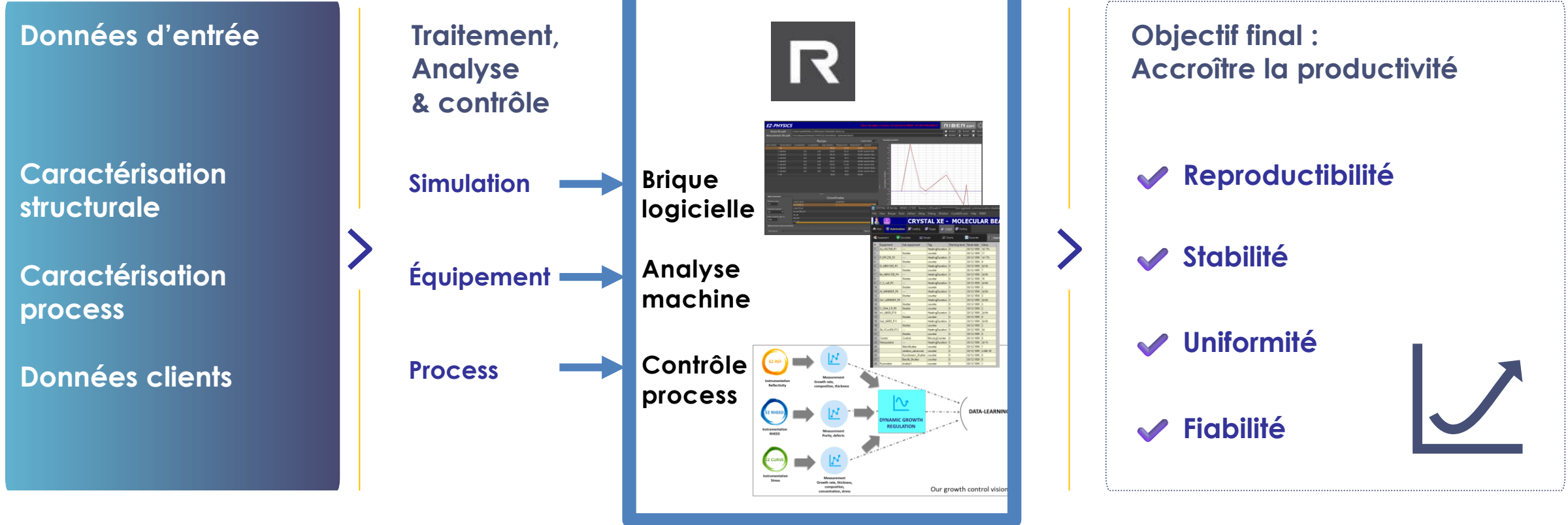


MBE + Sputtering

Versatilité



Vers une technologie augmentée par le machine learning



RIBER



Nos perspectives de développement

Dans la photonique intégrée sur Silicium

- Pour adresser cet enjeu, les données sont transmises sous forme d'onde lumineuse
- NVIDIA investit 4 milliards dans la **photonique** pour ses data centers IA

source : NVIDIA – MARS 2026



 NVIDIA

NVIDIA and Coherent Announce Strategic Partnership to Develop Optics Technology to Scale Next-Generation Data Center Architecture

NVIDIA to Invest \$2 Billion in Coherent to Expand Supply, Deepen R&D and Advance US-Based Manufacturing

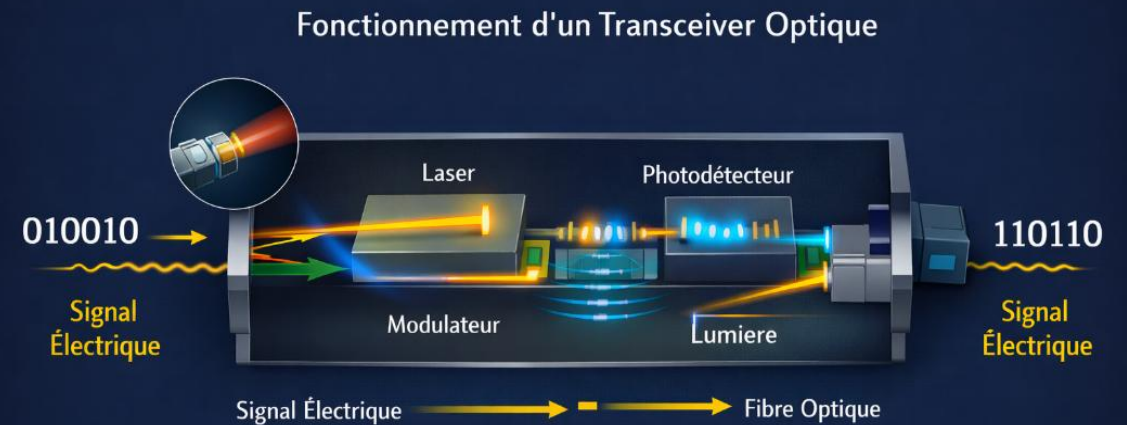
- Des débits qui explosent avec l'IA
 - les connexions entre serveurs doivent supporter des débits de : 100G => 400G => 800 G, ...
 - ... tout en garantissant rapidité, latence minimale, faible perte et efficacité énergétique élevée
- La lumière remplace désormais le cuivre.
 - Les interconnexions classiques en cuivre ne permettent plus d'accompagner cette montée en puissance



Le rôle clé du transceiver optique

Dans un datacenter, les transceivers convertissent les données électriques des serveurs en signaux optiques pour transporter rapidement l'information

- Dans le composant « transceiver », un élément fondamental : le **modulateur électro-optique**



Un laser reste allumé en continu, le signal électrique allume et éteint la lumière ce qui permet de coder l'information

- Compatibilité indispensable avec l'industrie silicium (CMOS)
 - La filière est construite sur le silicium : abondant, peu cher, disponible à grande échelle

Comparatif des Matériaux pour Modulateurs Électro-Optiques

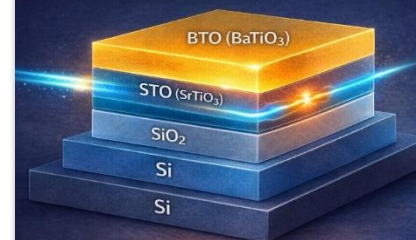
Matériau	Type	Avantages	Avantages	Inconvénients	Cas d'usage
LiNbO₃ Historique / Bulk	Historique / Bulk	✓ LiNbO ₃ (Niobate de lithium)	✓ Très stable ✓ Excellente linéarité ✓ Faibles pertes	✗ Volumineux ✗ Cher ✗ Intégration difficile	Télécom longue distance, haute performance
InP III-V (composés)	InP	✓ Intègre laser + modulateur ✓ Très rapide ✓ Compact	✓ Viés rapide ✓ Compact	✗ Coût élevé ✗ Fabrication complexe	Transceivers optiques (datacenter, télécom)
GaAs / III-V	GaAs	✓ Bonnes propriétés optiques ✓ Haute vitesse	✓ Moins standard que InP	✗ Moins standard que InP	Applications spécifiques RF / opto
Si (Photonique silicium)	Si	✓ Compatible industrie CMOS ✓ Très scalable ✓ Coût bas	✓ Effet EO faible ✓ Coût bas	✗ Effet EO faible nécessite structures complexes	Datacenters (volume, coût)
SiPh + III-V Hybride	InP	✓ Combine coût + performance ✓ laser intégré possible	✗ Complexité d'intégration	✗ Stabilité thermique limitée durée de vie	R&D, applications niche
Polymères EO		✓ Très forte efficacité EO ✓ Faible tension	✗ immature industriellement	✗ immature industriellement	Recherche avancée
BaTiO₃ Oxydes Nouvelle generation	Nouvelle generation	✓ Compact ✓ Très performant ✓ faible perte	✓ Oxipact ✓ Très performant	✗ encore coûteux	Next-gen (400G / 800G+)

Comparatif des techniques de dépôt

Technique	Qualité cristalline	Avantages	Inconvénients	Maturité
MBE	★★★★★ (excellente)	- Contrôle atomique - Très haute qualité - Interfaces propres	- Lent- - coûteux-	R&D / avancé
PLD (Pulsed Laser Deposition)	★★★★	- Bonne qualité cristalline - Rapide pour prototypage	- Non uniforme grande surface - peu scalable	R&D
CVD / MOCVD	★★★	- Compatible industrie - Scalable	- chimie complexe - défauts possibles	en développement
Sputtering (PVD)	★★	- Industriel - coût plus faible	- qualité cristalline limitée - besoin recuit	industriel (mais perf limitée)

- Le choix du matériau est un compromis entre performance, coût et intégration
- L'empilement BTO/STO sur silicium : une rupture technologique pour les modulateurs optiques

BTO / STO SUR SILICIUM



BTO= BaTiO₃ (Oxyde de Baryum de Titanate)
STO= SrTiO₃ (Oxyde de Strontium de Titanate)

- Les propriétés remarquables du BTO/STO/Si vont aussi adresser les marchés RF et des nouvelles technologies du quantique

6G /7G mobile

Emetteur / récepteur RF



STO sur Silicium

Nouvelles technologies du quantique

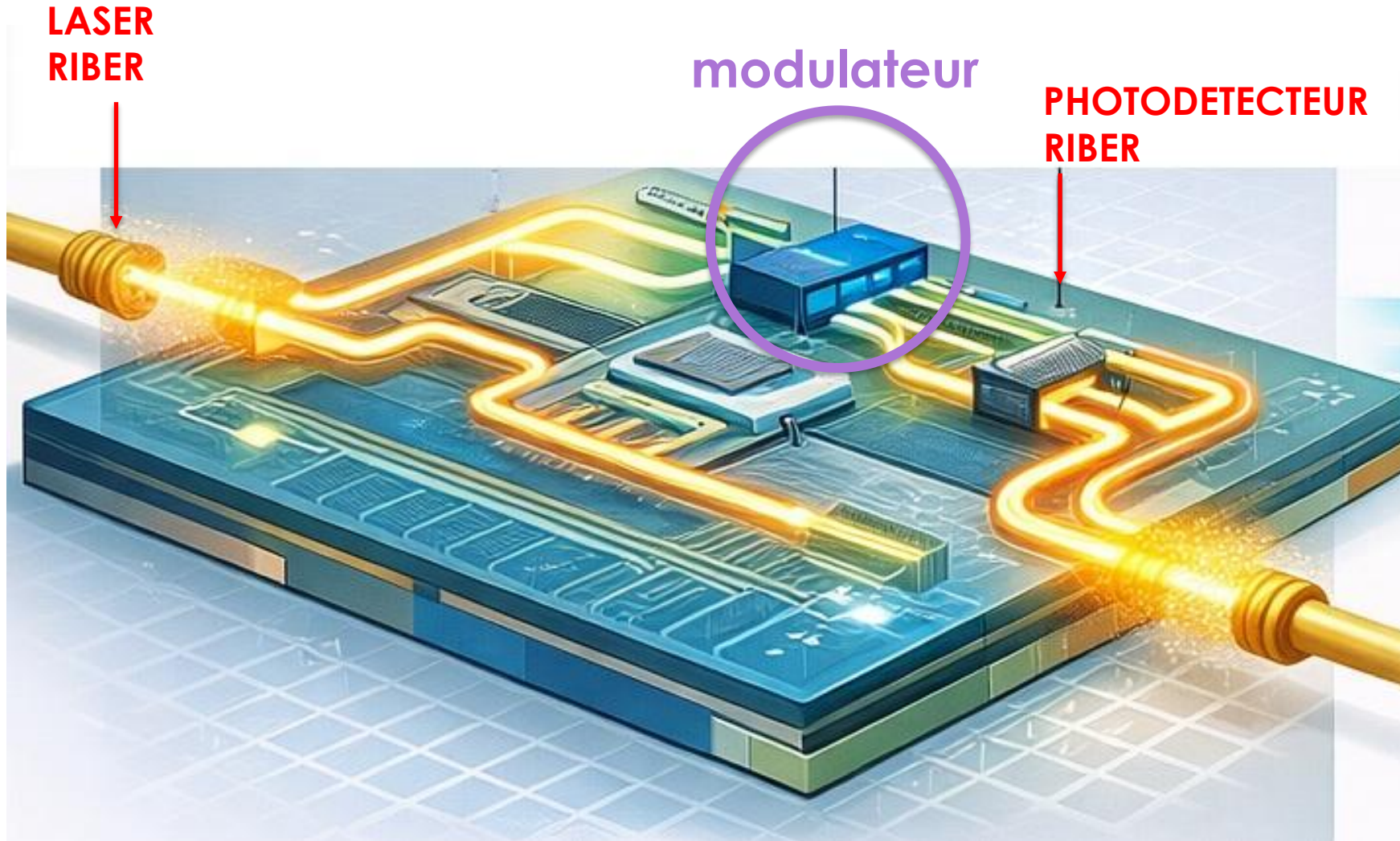
Pharmacologie Finance Optimisation logistique,
Chimie Cryptographie industrielle

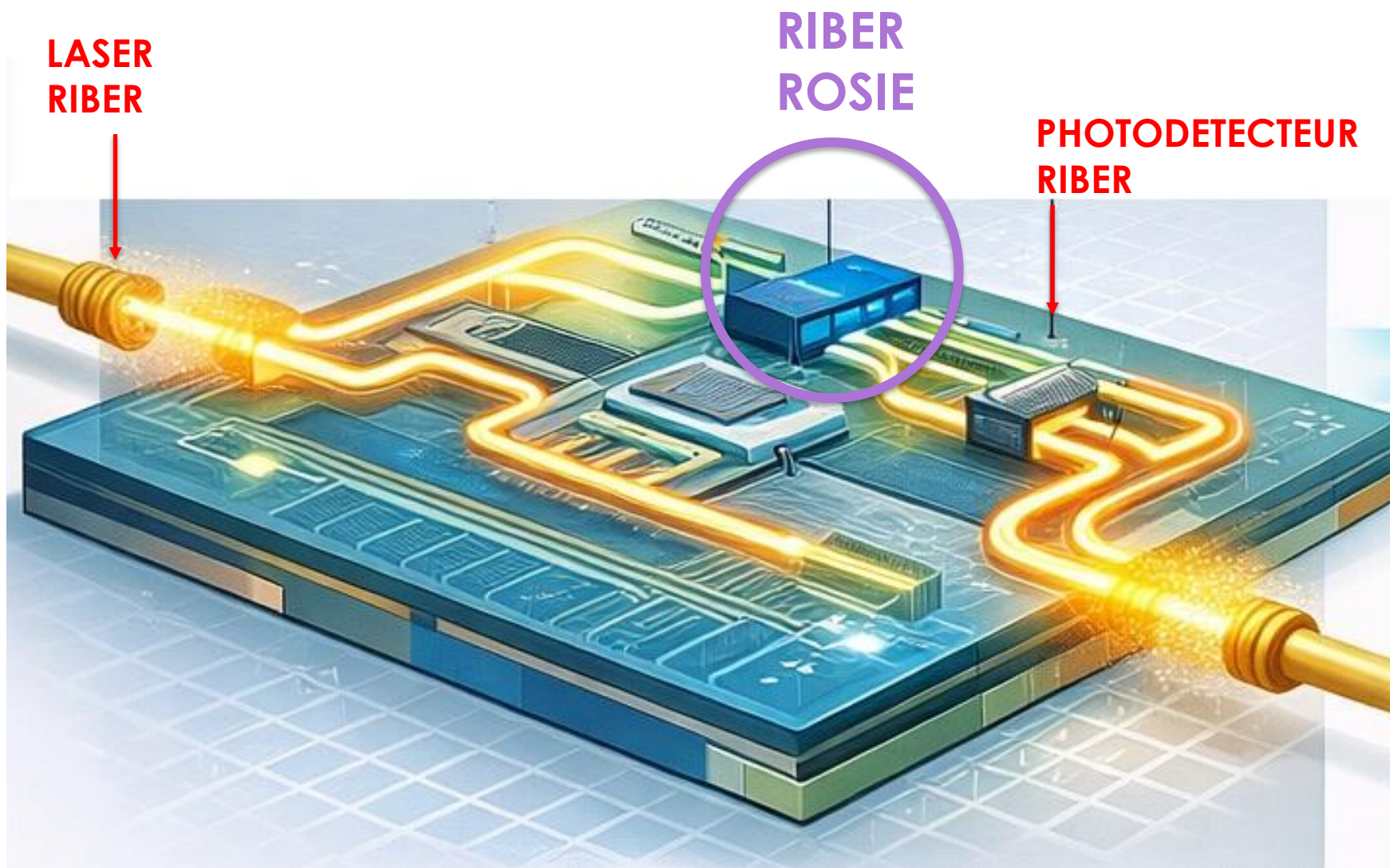


1-2 Md\$ en 2025
8-15 Md\$ en 2030
28-72 Md\$ en 2035

Source : McKinsey

BTO/STO sur Silicium



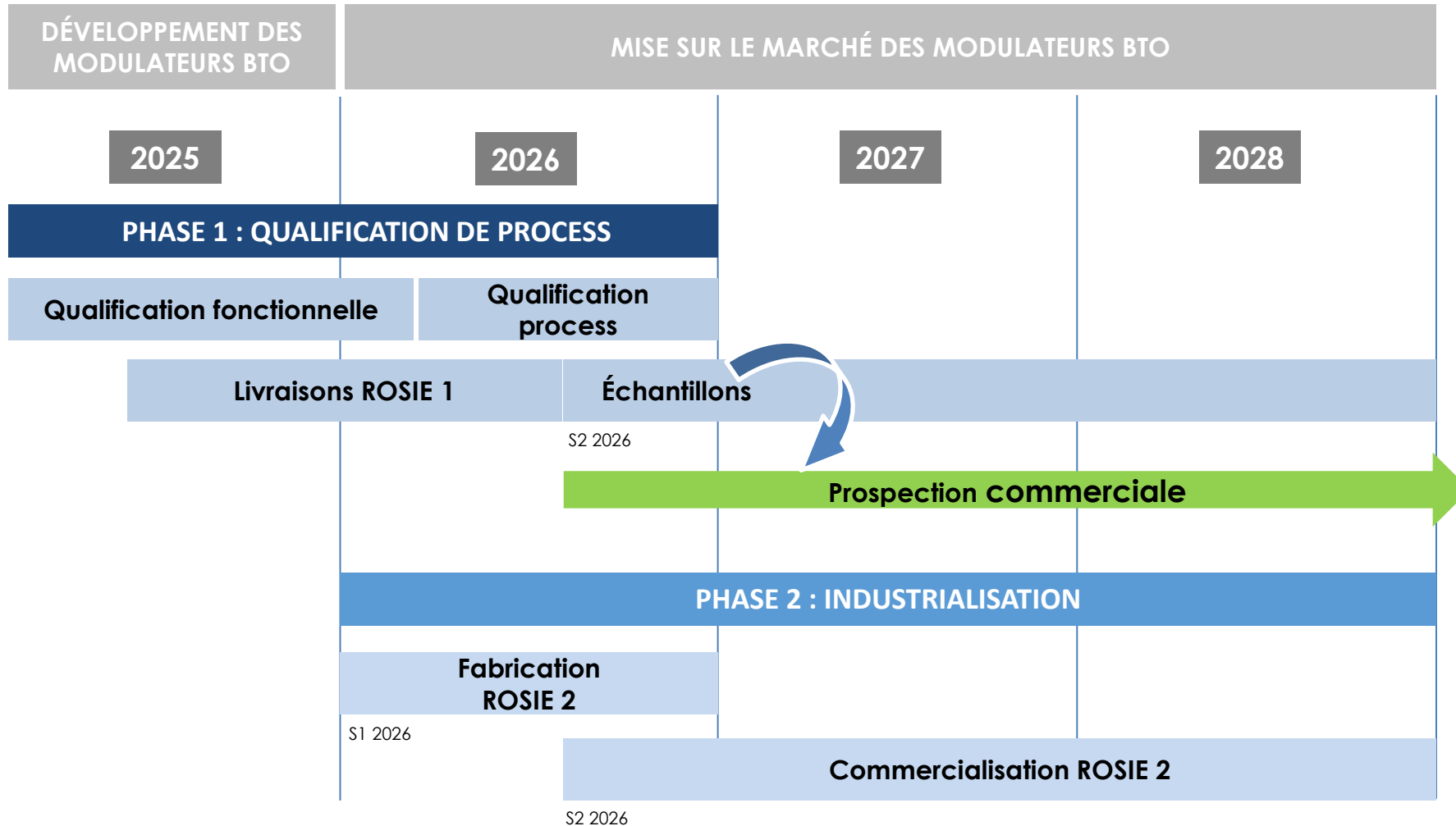


ROSIE – Riber Oxide Silicon Epitaxy

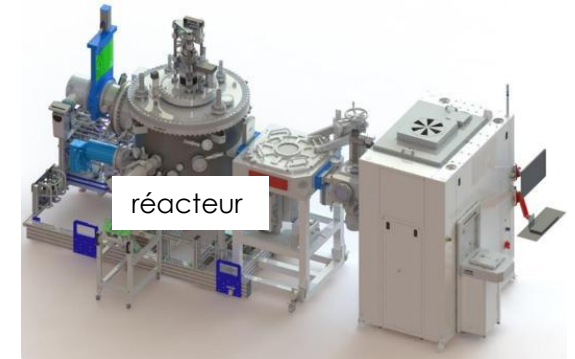
Une machine compatible avec l'industrie du silicium 300mm

Une machine avec un process BTO/STO pour produire la prochaine génération d'électro-modulateurs optiques



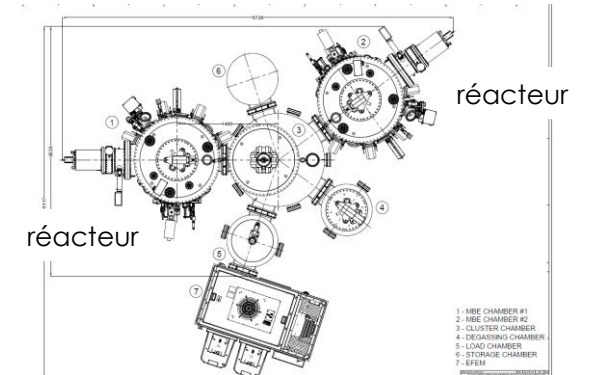


ROSIE 1



Démultiplier la productivité

ROSIE 2

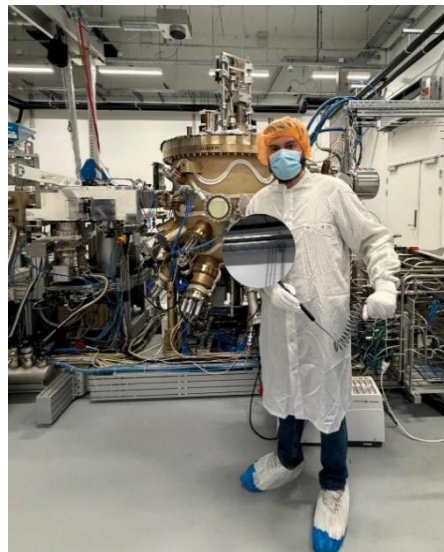


2025 : Partenariat POEM

NQCP/NBI Danemark EU



2025- 2028



Qualification, développement
des procédés BTO
Quantique et Datacom/Télécom

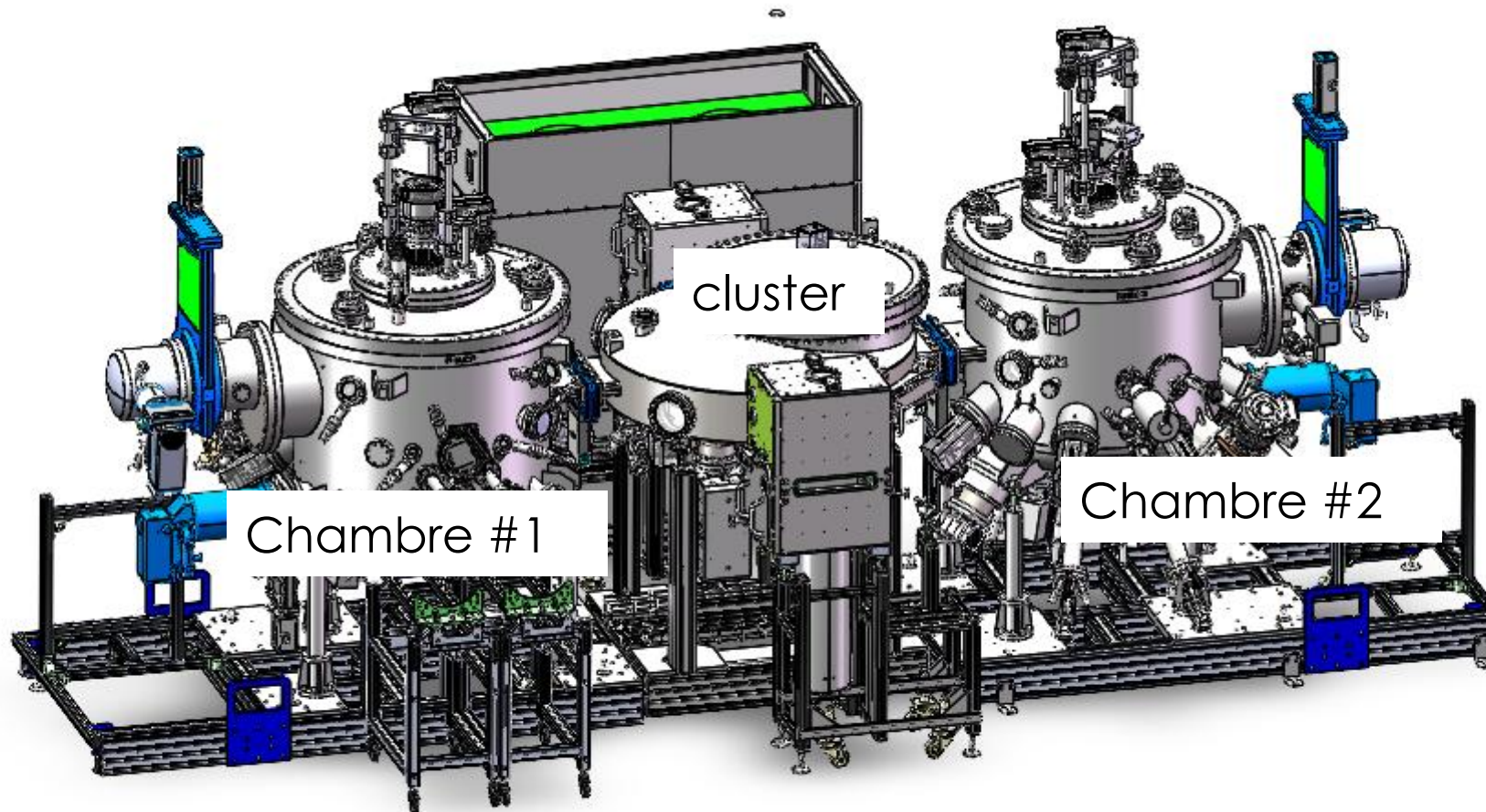
Vente / partenariat / sampling / process

2025 : Vente aux USA

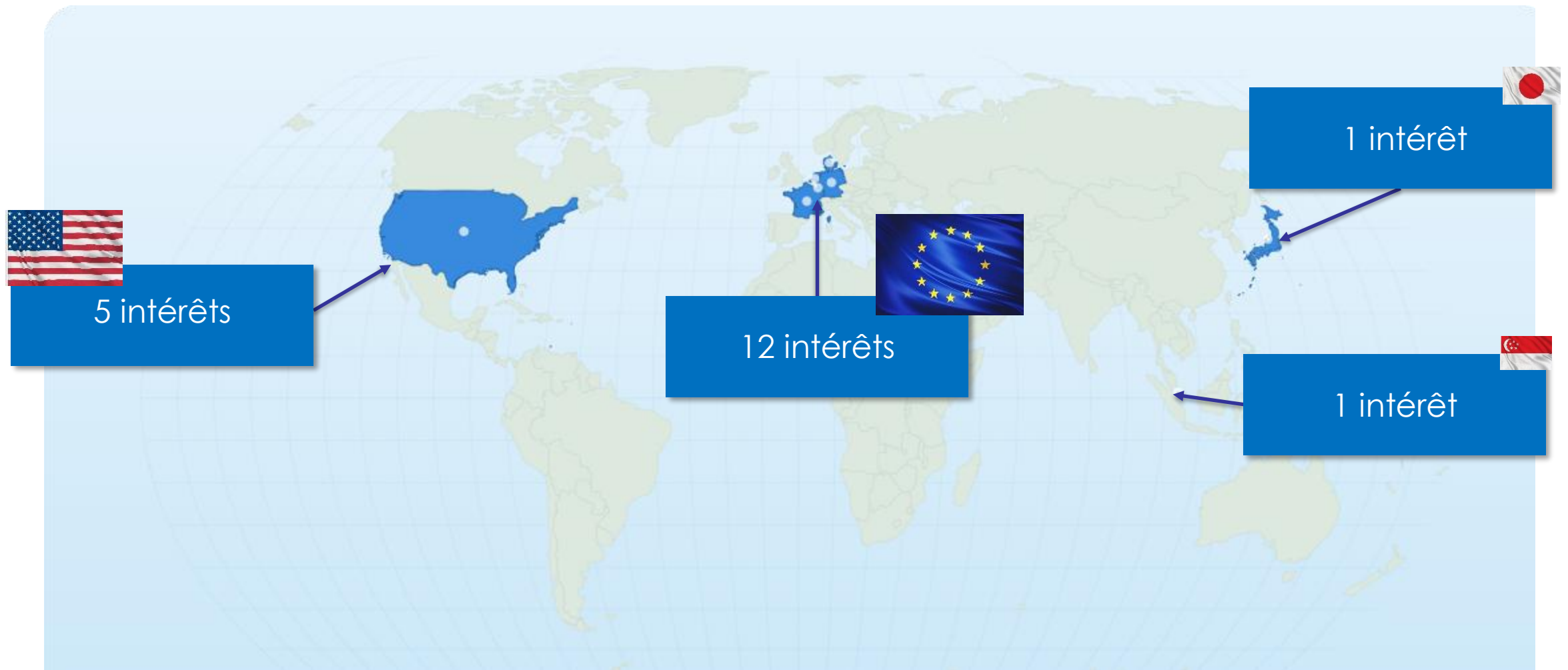


Acteur de pointe
de l'informatique quantique
aux États-Unis

Livraison S1 2026

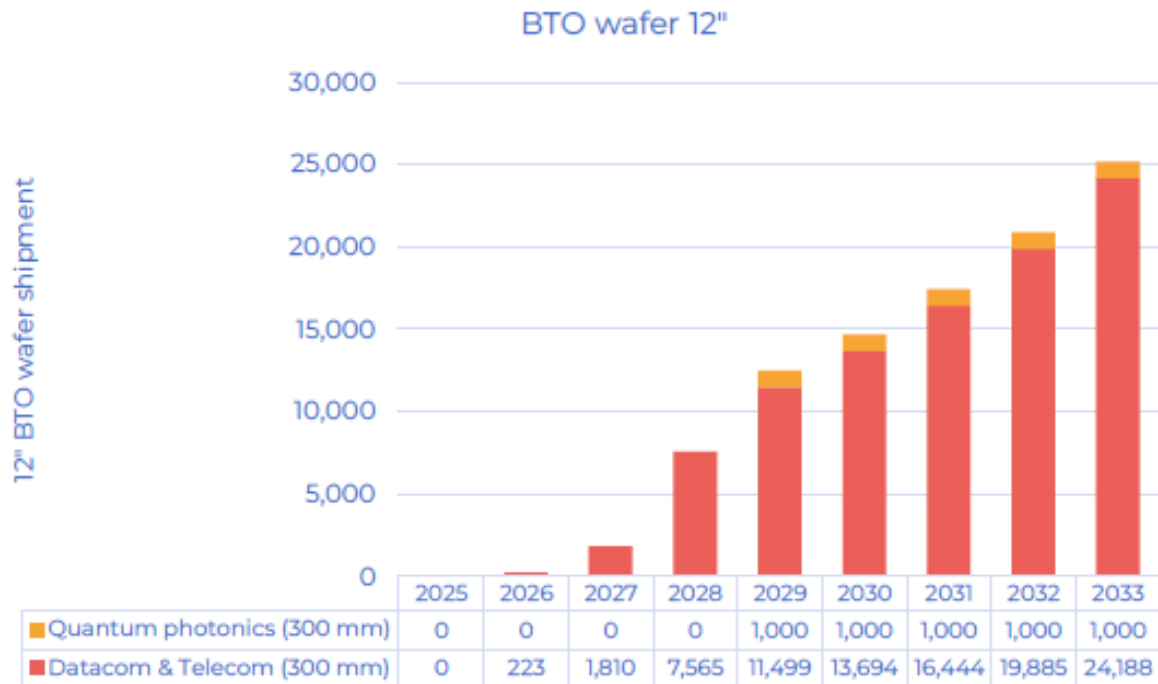


**UNE VERSION CLUSTER PERMETTANT D'AUGMENTER
LA CAPACITÉ, LA PRODUCTIVITÉ ET LA FLEXIBILITÉ**



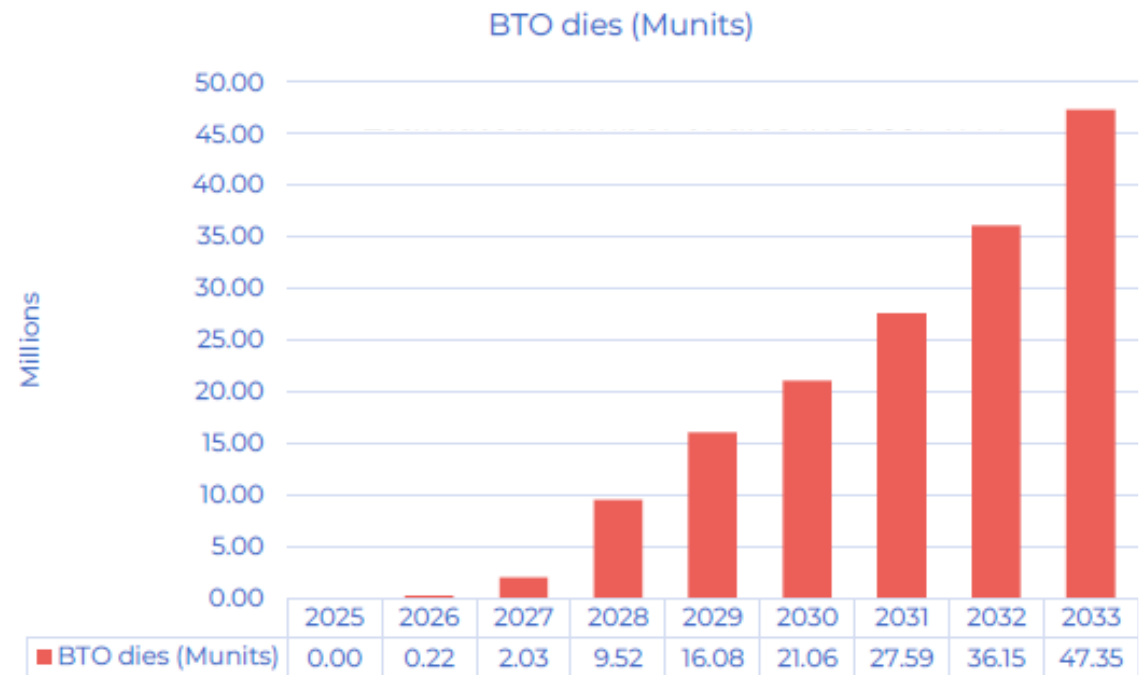
UN INTÉRÊT MONDIAL POUR LA TECHNOLOGIE ROSIE

Wafers BTO 300 mm.
(en unités)



Source : Yole Group 2025

Puces BTO
(en millions d'unités)



Une opportunité de marché en forte accélération dès 2027

La demande en wafers BTO 300 mm devrait être tirée par les besoins croissants en datacom et télécom.

Cette dynamique soutient la stratégie d'industrialisation du process ROSIE



De ROSIE vers une GAMME PRODUIT RIBER 300mm

RIBER 300

Silicon Fab compatible



DATACOM
TELECOM
Q.COMPUTING
OEM

BTO/STO

DISPLAY
SANTE
LED UV,
µLED

GaInNAs/GaN

TELECOM
Transistor RF

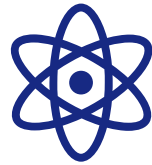
AlN/GaN

DATACOM
TELECOM
Laser PIC

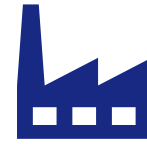
III-V



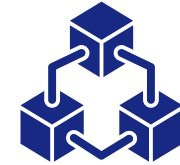
Une amélioration
significative
de notre rentabilité



Un marché accéléré
par l'IA, les
infrastructures de
données et la
photonique



Les premières
validations
commerciales de
ROSIE et une
trajectoire claire vers
l'industrialisation



Une technologie
différenciante au
cœur des
architectures de
nouvelle génération

Objectif :
transformer cette dynamique en croissance durable

RIBER

**Un acteur stratégique
des semi-conducteurs
de demain**

Contexte

Qu'est ce que la MBE (Molecular Beam Epitaxy) ?

Puissance, richesse, performance de la technologie MBE

La MBE se caractérise par un environnement sans contaminants obtenu grâce à la maîtrise de l'ultra haut vide. Ceci pour permettre un dépôt contrôlé à la monocouche atomique (3 Ångströms) afin de réaliser des nanostructures avec un contrôle parfait des interfaces.

Réalisation d'une nanostructure :

- 1- Sur un substrat chauffé
- 2- Des matériaux solides ultra purs sont disposés dans des cellules orientées en direction du substrat. Ces matériaux sont chauffés à haute température pour permettre leur sublimation.
- 3- Les conditions UHV en plus de la géométrie de l'équipement, envoient les atomes directement sur la surface du substrat. Les atomes vont se 'coller' sur la surface et former une 'couche' atomique.
- 4- Tout atome n'atteignant pas la surface du substrat est piégé sur une surface froide entourant l'équipement afin de ne pas contaminer la couche suivante.
- 5- Le type d'empilement des couches et les matériaux utilisés permettent de réaliser des nanostructures émettant de la lumière 'photonique' ou des électrons (électronique).

